

	<h2 style="color: red;">FDB86360-F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB86360-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 110A TO263
	Datenblätter:  FDB86360-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 630 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB86360-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 110A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	630 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	333W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB86360-F085CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	253nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 110A (Tc) 333W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDB86360-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB86360-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB86360-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB86360-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB86135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>	 <p>FDB86360_SN00307 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V</p>	 <p>FDB86360 FAIRCHI FDB86360 FAIRCHI</p>	 <p>FDB86363-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>
 <p>FDB86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB86363_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB86363_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB86363 FAIRCHI FDB86363 FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB86360-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB86360-F085 Datenblatt	FDB86360-F085-Datenblätter	FDB86360-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB86360-F085
FDB86360-F085 Electronic	FDB86360-F085-Komponenten	FDB86360-F085-Verteiler	FDB86360-F085-Bild	FDB86360-F085-Teil
FDB86360-F085 Preis	FDB86360-F085 Hersteller	FDB86360-F085 Bild	FDB86360-F085 Aktie	FDB86360-F085 Inventar
FDB86360-F085 Neu	FDB86360-F085 Original	FDB86360-F085 garantiert	FDB86360-F085 RFQ	FDB86360-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited